

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2009年3月19日 (19.03.2009)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2009/035087 A1

- (51) 国際特許分類:
G03F 7/40 (2006.01) H01L 21/027 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2008/066556
- (22) 国際出願日: 2008年9月12日 (12.09.2008)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2007-236974 2007年9月12日 (12.09.2007) JP
- (71) 出願人 (アラブ首長国連邦, アンティグア・バーブーダ, アルバニア, アルメニア, アンゴラ, オーストラ

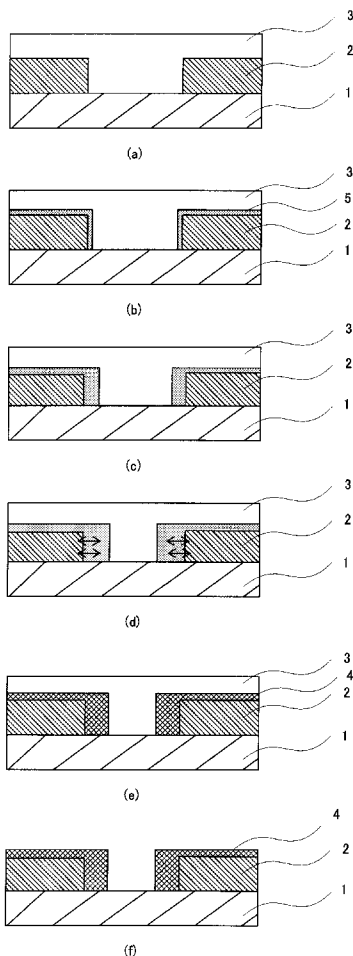
リア, アゼルバイジャン, ボスニア・ヘルツェゴヴィナ, パルバドス, ブルキナ・ファソ, バーレーン, ベナン, ブラジル, ボツワナ, ベラルーシ, ベリーズ, カナダ, 中央アフリカ, コンゴ, コートジボアール, カメルーン, 中国, コロンビア, コスタリカ, キューバ, ドミニカ, ドミニカ共和国, アルジェリア, エクアドル, エジプト, ガボン, グレナダ, グルジア, ガーナ, ガンビア, ギニア, 赤道ギニア, グアテマラ, ギニア・ビサオ, ホンジュラス, クロアチア, インドネシア, イスラエル, インド, ケニア, キルギス, コモロ, セントキッツ・ネーヴィス, 北朝鮮, 韓国, カザフスタン, ラオス, セントルシア, スリランカ, リベリア, レソト, 大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国, モロッコ, モルドヴァ, モンテネグロ, マダ

[続葉有]

(54) Title: COMPOSITION FOR FORMING SILICON-CONTAINING FINE PATTERN AND METHOD FOR FORMING FINE PATTERN USING THE SAME

(54) 発明の名称: ケイ素含有微細パターン形成用組成物およびそれを用いた微細パターン形成方法

[図1]



(57) Abstract: Disclosed is a composition for forming a fine pattern, which enables to form a fine pattern having high dry etching resistance. Also disclosed is a method for forming such a fine pattern. The composition contains a resin containing a repeating unit having a silazane bond, and a solvent. The method for forming a fine pattern comprises a step for processing a resist pattern with such a composition.

(57) 要約: 本発明は、ドライエッチング耐性の高い微細パターンを形成させるための微細パターン形成用組成物と、その微細パターンを形成させる方法を提供するものである。この組成物は、シラザン結合を有する繰り返し単位を含んでなる樹脂と、溶剤とを含んでなる。また、本発明による微細パターン形成方法は、その組成物を用いてレジストパターンを処理する工程を含んでなる。



ガスカル、マケドニア旧ユーゴスラヴィア共和国、マリ、モンゴル、モーリタニア、マラウイ、メキシコ、マレーシア、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、ニカラグア、ノールウェー、ニュージランド、オマーン、パプアニューギニア、フィリピン、セルビア、ロシア、セーシェル共和国、スーダン、シンガポール、シエラレオーネ、サン・マリノ、セネガル、エルサルバドル、シリア・アラブ共和国、スワジランド、チャード、トーゴ、タジキスタン、トルクメニスタン、チュニジア、トリニダード・トバゴ、タンザニア、ウクライナ、ウガンダ、ウズベキスタン、セント・ヴィンセント及びグレナディーン諸島、ヴィエトナム、南アフリカ共和国、ザンビア、ジンバブエについてのみ): AZエレクトロニックマテリアルズ株式会社 (AZ ELECTRONIC MATERIALS (Japan) K.K.) [JP/JP]; 〒1130021 東京都文京区本駒込2丁目28番8号 文京グリーンコート Tokyo (JP).

- (71) 出願人 (オーストリア、ベルギー、ブルガリア、スイス、キプロス、チェッコ、ドイツ、デンマーク、エストニア、スペイン、フィンランド、フランス、英国、ギリシャ、クロアチア、ハンガリー、アイルランド、アイスランド、イタリア、リトアニア、ルクセンブルグ、ラトヴィア、モナコ、マルタ、オランダ、ノールウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スウェーデン、スロヴェニア、スロヴァキア、トルコについてのみ): AZエレクトロニックマテリアルズUSAコーポレーション (AZ ELECTRONIC MATERIALS USA CORP.) [US/US]; 08876 ニュージャージー州サマーヴィル マイスターアベニュー70 New Jersey (US).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): ダンメル ラルフ. アール (DAMMEL, Ralph. R) [US/US]; 08876 ニュージャージー州サマーヴィル マイスターアベニュー70 AZエレクトロニックマテリアルズUSAコーポレーション内 New Jersey (US). カン

ウェンビン (KANG, WenBing) [CN/JP]; 〒4371412 静岡県掛川市千浜3330 AZエレクトロニックマテリアルズ株式会社内 Shizuoka (JP). 清水 泰雄 (SHIMIZU, Yasuo) [JP/JP]; 〒4371412 静岡県掛川市千浜3330 AZエレクトロニックマテリアルズ株式会社内 Shizuoka (JP). 石川 智規 (ISHIKAWA, Tomonori) [JP/JP]; 〒4371412 静岡県掛川市千浜3330 AZエレクトロニックマテリアルズ株式会社内 Shizuoka (JP).

- (74) 代理人: 吉武 賢次, 外(YOSHITAKE, Kenji et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 富士ビル323号 協和特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書